【筑波　GaN基盤製造のフォトリソグラフィ工程における生産技術】ご経験者を募集しています。

国内最大手の石油化学メーカー

募集職種

人材紹介会社
株式会社グローバル・リサーチ

採用企業名
国内最大手の石油化学メーカー

求人ID
1603603

部署名
茨城事業所

業種
化学・素材

会社の種類
大手企業 (300名を超える従業員数)

雇用形態
正社員

勤務地
茨城県, 牛久市

給与
750万円 ~ 1300万円

更新日
2026年11月05日 06:00

応募必要条件

職務経験
6年以上

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
基礎会話レベル

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

本ポジションでは、GaN基板製造の下地工程（種結晶＝シードの作製）におけるフォトリソグラフィ工程を中心に、プロセス改善・生産技術の確立をご担当いただきます。具体的には以下の通りです。

＜担当業務項目＞
プロセス開発・条件最適化 ：GaN（窒化ガリウム）基板の製造プロセスにおける、フォトリソグラフィー工程やドライ

エッチング工程の条件検討及び最適化を行い、高品質なGaN基板を安定的に生み出すダイナミックな業務です。サファイア基板へのMOCVDによる薄膜形成後、プラズマCVDによるマスク形成、フォトレジスト塗布、パターニング、現像、ドライエッチング、レジスト除去までの一連の工程を扱います。マスクの形状・幅・高さ・材質はその後のHVP結晶成長の品質に直結するため、条件検討・最適化がこの技術の核心です。
・評価データ、プロセスデータの解析、解析技術の開発
　自ら作成したサンプルを評価・解析し、結果を製造プロセスへ反映させます。
　専門的な知見を活かした高度な解析が、世界最高水準の製品の品質向上に直結する重要な役割です。
・化合物半導体のエピタキシャル成長技術の開発、国内外の社外委託先検討及び技術開発
　MOCVD等による薄膜形成の経験も大いに活かせる環境です。

スキル・資格

【必須条件】
・理工系（物理、化学、化学工学、材料科学、機械工学、電気・電子工学　等）を専攻された方
・半導体・電子部品・化学・材料いずれかの業界における製造ないしは開発・生産技術の実務経験（目安3年以上）をお持ちの方
・下記のいずれかの実務経験（GaNに関する経験は特に歓迎。最先端の知見は不問で、基礎的なプロセス技術があれば可）
　- 半導体材料（GaN、SiC、Si、サファイア、脆性材料等）のフォトリソグラフィプロセスの経験
　- 金属膜、酸化膜等の成膜技術（プラズマCVDやスパッタ等）
・下記の能力を保有している方
　- 半導体材料のフォトリソグラフィ技術・成膜技術の専門知識を有する
　- 製造現場（オペレーター）を巻き込み、指示書をもとに工程を動かしていけるコミュニケーション力
　- 安全を最優先に業務を遂行する意識

【歓迎要件】
・物理、化学、化学工学、材料科学、機械工学、電気・電子工学を専攻された方
・化合物半導体（GaN、SiC等）のデバイス・基板の開発 / 量産に携わった経験をお持ちの方
・経験職種
- 化合物半導体の結晶成長技術（MOCVD等）の経験
- 化合物半導体の評価技術、熱・流体・構造の計算機シミュレーションの経験
- 将来的にチームを牽引するリーダー / マネジメントを志向される方（技術者でありながらマネジメントにも意欲のある方）
・語学力：英語

会社説明

国内最大手の石油化学メーカー